

# Electromagnetic Pulse Coupling to Transmission Lines on Silicon Substrate

黃萬賓、邱政男

E-mail: 9303428@mail.dyu.edu.tw

## ABSTRACT

The purpose of this thesis is to examine the effects of electromagnetic pulse coupling to the transmission lines on silicon substrate。The theory of the field coupling to the transmission lines on silicon substrate is derived。Based on the theory , the transfer function in frequency domain is obtained。The transient response in time domain is then evaluated by using the inverse Fourier transformation of the multiplication of the transfer function and the electromagnetic pulse in frequency domain。Numerical results of the transient response are shown and discussed。In particular , the effects owing to the rising and falling time of the electromagnetic pulse , the configuration of the transmission lines , and the load impedance , are studied in detail。

Keywords : EMP ; EMI ; EMS

## Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v 誌	
謝.....	vi	目錄.....	vii	圖目錄.....	ix 第一章 緒	
論.....	11.1 研究動機與目的.....	11.2 大綱.....	2 第二章 入射場耦合至矽			
基板上傳輸線之理論.....	4.2.1 簡介.....	4.2.2 BLT方程式.....	4.2.2.1 入射場耦合至矽基			
板傳輸線之傳輸線方程式.....	4.2.2.2 單位長矽基板傳輸線之RLCG參數與反射係數.....	4.2.3 終端條件.....	9 第三			
章 電路參數及反射係數.....	13.3.1 簡介.....	13.3.2 單位長電阻、電感.....	13.3.3 單			
位長電容、電導.....	15.3.4 脈衝波入射矽間板上之反射係數.....	18 第四章 結果與討	位			
論.....	24.4.1 簡介.....	24.4.2 脈衝波入射矽基板傳輸線時頻域之轉換流程圖....	24.4.3 改變入			
射脈衝波的a1、a2值之電流響應.....	25.4.4 改變矽基板傳輸線尺寸之電流響應.....	26.4.5 改變傳輸線的終端負載之電				
流響應.....	26.4.5.1 純電阻性的終端負載.....	27.4.5.2 具電容性的終端負載.....	27.4.5.3 具電感性的終端			
負載.....	27.4.5.1 純電阻性的終端負載.....	27.4.5.2 具電容性的終端負載.....	負載.....			
28 第五章 結論.....	41 參考文獻.....	43 圖目錄 圖1.1 電磁脈衝入射	28			
至矽基板傳輸線之示意圖.....	3 圖2.1 矽基板上傳輸線之側視圖.....	11 圖2.2 矽基板上傳輸線之立體	第五章			
圖.....	11 圖2.3 矽基板上傳輸線之集總等效電路.....	12 圖2.4 集總等效電路配合終端條件.....	結論.....			
11 圖2.3 矽基板上傳輸線之集總等效電路.....	12 圖2.4 集總等效電路配合終端條件.....	12 圖3.1 矽	41			
基板上傳輸線側視圖.....	19 圖3.2 矽基板上傳輸線立體圖.....	19 圖3.3 鏡像高度(heff)之示意	參考文獻.....			
圖.....	20 圖3.4 heff結果之比對.....	20 圖3.5 近似解之單位長電阻.....	43			
20 圖3.4 heff結果之比對.....	20 圖3.5 近似解之單位長電阻.....	21 圖3.6 近似解之單位	圖目錄			
長電感.....	21 圖3.7 電導、電容之集總等效電路示意圖.....	21 圖3.6 近似解之單位	圖			
21 圖3.7 電導、電容之集總等效電路示意圖.....	22 圖3.8 近似解之單位長電導.....	22	1.1			
22 圖3.9 近似解之單位長電容.....	23 圖4.1 矽基板傳輸線之結構.....	29 圖4.2 脈衝波入射矽基板傳輸線時	電磁脈衝入射			
23 圖4.1 矽基板傳輸線之結構.....	29 圖4.3 脈衝波之頻域表示圖.....	29 圖4.4 矽基板傳輸線之頻域響應.....	矽基板傳輸線時			
29 圖4.3 脈衝波之頻域表示圖.....	30 圖4.4 矽基板傳輸線之頻域響應.....	30 圖4.5 矽基板傳輸線兩終端之耦合電流.....	頻域之轉換流程示意圖			
30 圖4.4 矽基板傳輸線之頻域響應.....	31 圖4.6 入射脈衝波(改變a1).....	31 圖4.7 改變a1後之耦合電	示意圖			
31 圖4.6 入射脈衝波(改變a1).....	31 圖4.7 改變a1後之耦合電	32 圖4.8 入射脈衝波(改變a2).....	32 圖4.9 改變a2後之耦合電流.....	33 圖4.10 矽基板傳	圖	
32 圖4.8 入射脈衝波(改變a2).....	32 圖4.9 改變a2後之耦合電流.....	33 圖4.10 矽基板傳	輸線之耦合電流(改變線寬).....	33 圖4.11 矽基板傳輸線之耦合電流(改變?緣層厚度)....	34 圖4.12 矽基板傳輸線之耦合電流(	圖
33 圖4.9 改變a2後之耦合電流.....	33 圖4.11 矽基板傳輸線之耦合電流(改變?緣層厚度)....	34 圖4.12 矽基板傳輸線之耦合電流(	改變矽導電率).....	34 圖4.13 矽基板傳輸線之耦合電流(改變矽介質厚度)....	35 圖4.14 矽基板傳輸線之耦合電流(改變矽基板傳	圖
34 圖4.10 矽基板傳輸線之耦合電流(改變線寬).....	34 圖4.12 矽基板傳輸線之耦合電流(	35 圖4.14 矽基板傳輸線之耦合電流(	35 圖4.15 改變兩終端負載值之耦合電流.....	36 圖4.16 改變兩終端負載值之耦合電壓.....	36 圖4.17 兩	圖
35 圖4.13 矽基板傳輸線之耦合電流(改變矽介質厚度)....	35 圖4.14 矽基板傳輸線之耦合電流(	36 圖4.15 改變兩終端負載值之耦合電流.....	36 圖4.16 改變兩終端負載值之耦合電壓.....	36 圖4.17 兩	終端為電容性負載之耦合電流(改變電阻值).....	圖
36 圖4.14 矽基板傳輸線之耦合電流(	36 圖4.16 改變兩終端負載值之耦合電壓.....	36 圖4.17 兩終端為電容性負載之耦合電流(改變電阻值).....	37 圖4.18 兩終端為電容性負載之耦合電壓(改變電阻值).....	37 圖4.19 兩終端為電	終端為電容性負載之耦合電流(改變電容值).....	圖
37 圖4.16 改變兩終端負載值之耦合電壓.....	37 圖4.18 兩終端為電容性負載之耦合電壓(改變電阻值).....	37 圖4.19 兩終端為電容性負載之耦合電流(改變電容值).....	38 圖4.20 兩終端為電容性負載之耦合電壓(改變電容值).....	38 圖4.21 兩終端為電感性負載之耦合電流(改變電阻值).....	39 圖4.22 兩終端為電感性負載之耦合電壓(改變電阻值).....	圖
38 圖4.19 兩終端為電容性負載之耦合電流(改變電容值).....	38 圖4.20 兩終端為電容性負載之耦合電壓(改變電容值).....	38 圖4.21 兩終端為電感性負載之耦合電流(改變電阻值).....	39 圖4.23 兩終端為電感性負載之耦合電流(改變電感值).....	39 圖4.24 兩終端為電感性負載之耦合電壓(改變電感值).....	40 圖4.24 兩終端為電感性負載之耦合電壓(改變電感值).....	圖

## REFERENCES

- [1]W. A. Chisholm and W. Janischewskyj, " Lightning surge response of ground electrodes , " IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 4, No.2, April 1989.
- [2]E. F. Vance and M. A. Uman, " Differences between lightning and nuclear electromagnetic pulse interactions, " IEEE Trans. on Electromag. Compat., Vol. 30, No.1, Feb. 1988.

- [3]D. A. Pucknell and K. Eshraghian, Basic VLSI Design, Prentice-Hall, 1994.
- [4] C. A. Nucci, and F. Rachidi, " On Field-to-Transmission Line Coupling Models, " Proceedings of the Progress in Electromagnetic Research Symposium, ESA, Noordwijk, The Netherlands, July 11-15, 1995.
- [5]F.M. Tesche and M.V. Ianoz, EMC Analysis Methods and Computational Model, John Wiley & Sons, 1997.
- [6]A. Weisshaar, H. Lan, and A. Luoh, " Accurate Closed Form Expressions for the Frequency Dependent Line Parameters of On Chip Interconnects on Lossy Silicon Substrate, " IEEE Transaction on Advanced Packaking, vol. 25, No.2, pp. 288-296, 2002 [7]Y. J. Yoon and B. Kim, " A new formula for effective dielectric constant in multi-dielectric layer microstrip structure, " in Proc. IEEE 9th Topical Meeting Elect. Performance Electron. Packag. (EPEP ' 00),pp. 163-167, 2000 [8]E. Hammerstad, et al., " Accurate Models for microstrip Computer Aided Design ", In IEEE MTT-S Microwave Symp. Dig., pp.407,1980 [9]D. K. Cheng , Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley.